

國碩科技工業 股份有限公司

(2406)

105年第三季法人說明會

105年11月23日

豁免聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

公司概況

成立時間	1997年3月4日
上市時間	2000年4月29日
董事長	陳繼明
總經理	蔡禮全
股本	33.89億台幣
營收項目	導電漿料 ’ 矽晶片 ’ EPC ’ Ribbon ’ 低溫固材
工廠	新竹 ’ 泰國

國碩科技

簡明合併資產負債表				
	(單位:千元)			
	105.9.30	%	104.9.30	%
流動資產	16,309,331	63.40	11,690,522	62.29
非流動資產	9,417,108	36.60	7,076,411	37.71
資產總額	25,726,439	100.00	18,766,933	100.00
流動負債	9,865,971	38.35	5,876,601	31.32
非流動負債	5,520,498	21.46	4,904,531	26.13
負債總額	15,386,469	59.81	10,781,132	57.45
股本	3,388,970	13.18	3,108,278	16.56
資本公積	2,699,792	10.49	2,357,710	12.56
保留盈餘	285,621	1.11	(39,994)	-0.21
其他權益	223,857	0.87	(54,627)	-0.29
非控制權益	3,741,730	14.54	2,614,434	13.93
股東權益	10,339,970	40.19	7,985,801	42.55

簡明合併損益表 (單位:千元)

	105前三季	%	104前三季	%
營業收入	14,184,304	100.00	12,889,594	100.00
營業毛利	2,050,428	14.46	1,780,991	13.82
營業利益	1,302,435	9.18	1,118,964	8.68
營業外收入及支出	109,005	0.77	(112,545)	(0.87)
稅前淨利	1,411,440	9.95	1,006,419	7.81
本期淨利	881,816	6.22	605,106	4.69
每股盈餘(元)	0.50		(0.52)	
淨利歸屬於母公司	168,193		(160,138)	
淨利歸屬於非控制權益	713,623		765,244	

簡明合併損益表 (單位:千元)

	105Q3	%	104Q3	%
營業收入	3,478,962	100.00	5,202,934	100.00
營業毛利	199,668	5.74	824,023	15.84
營業利益	(23,785)	(0.68)	540,298	10.38
營業外收入及支出	274,124	7.88	202,778	3.90
稅前淨利	250,339	7.20	743,076	14.28
本期淨利	95,945	2.76	555,804	10.67
每股盈餘(元)	(0.45)		0.44	
淨利歸屬於母公司	(153,421)		134,344	
淨利歸屬於非控制權益	249,366		421,460	

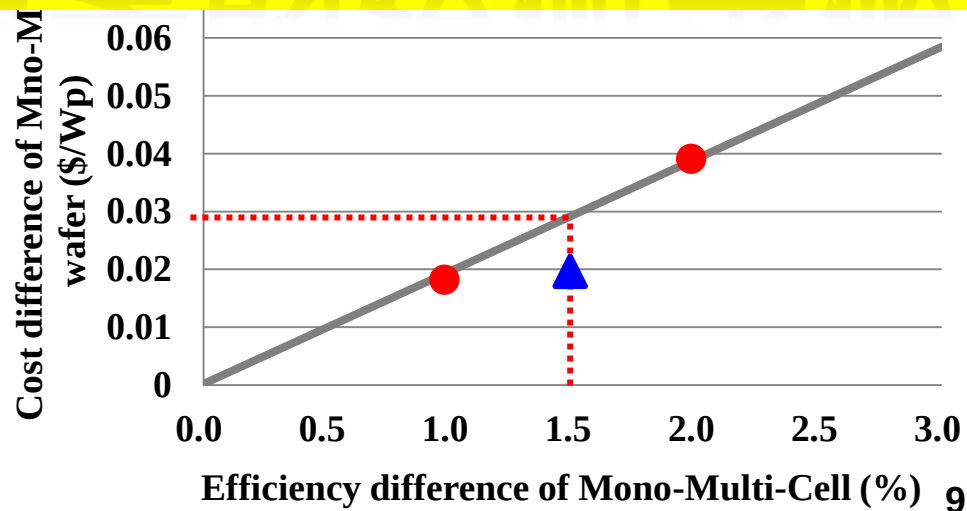
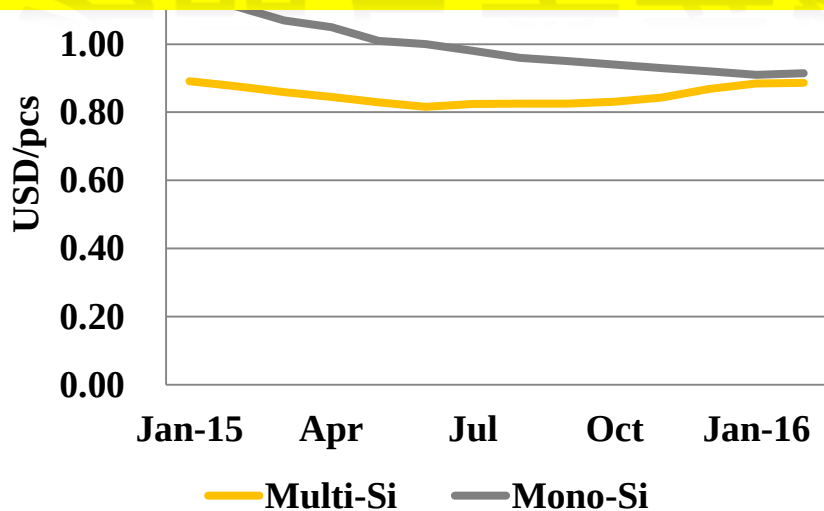
簡明合併現金流量表			(單位:千元)
	105前三季	104前三季	
營業活動之淨現金流入	1,808,078	467,630	
投資活動之淨現金流出	(1,354,178)	(974,615)	
籌資活動之淨現金流入	3,716,538	671,396	
匯率變動之影響	(161,011)	112,011	
本期現金及約當現金增加數	4,009,427	276,422	
期初現金及約當現金餘額	3,717,085	2,027,249	
期末現金及約當現金餘額	7,726,512	2,303,671	

國碩科技的**wafer**技術布局

多晶與單晶wafer的競爭

- 單晶與多晶最大的成本差異來自於wafer的治工費
- 以目前效率, 單晶19.9%/多晶18.4% ($\Delta=1.5\%$),
當成本差 < \$0.15/pcs (\$0.03/Wp), 單晶具強烈優勢
(更何況目前售價差~\$0.1/pcs)

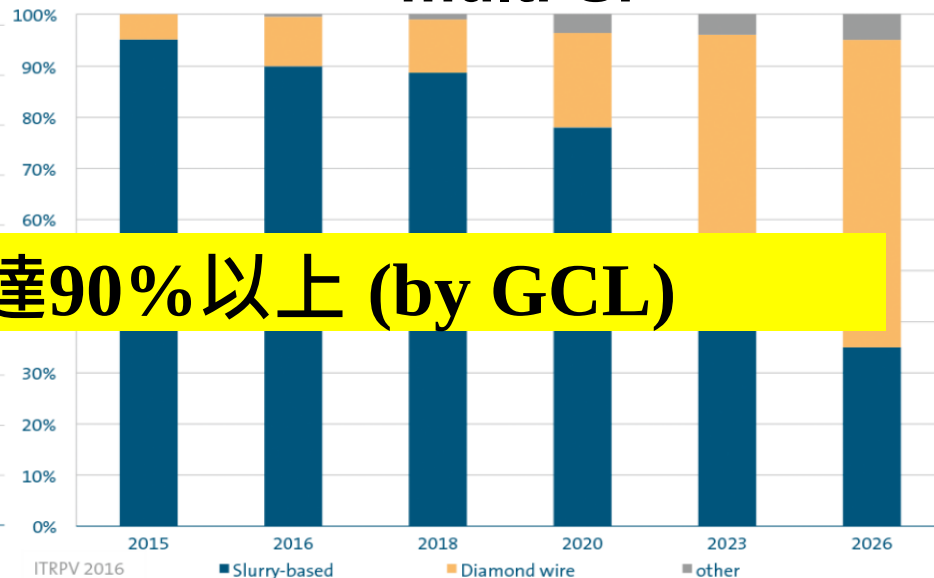
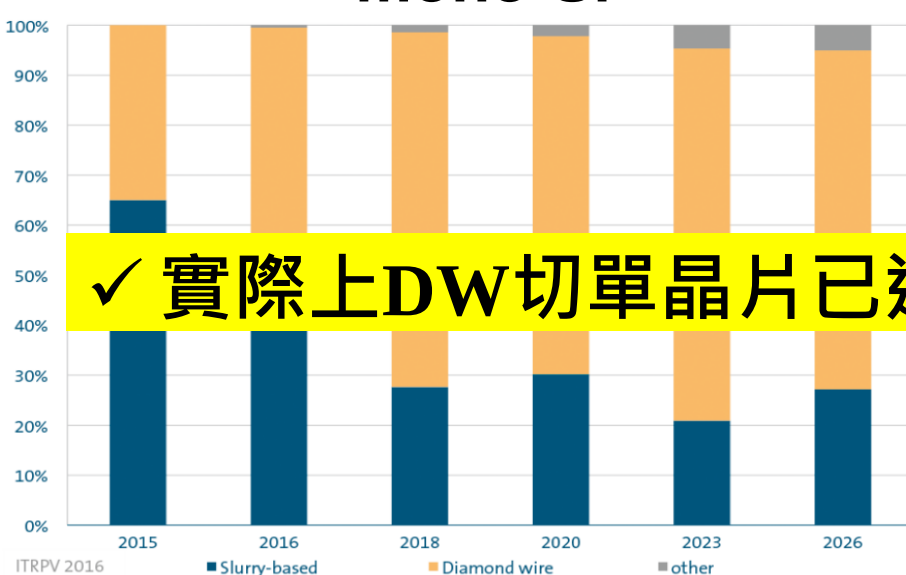
多晶片需要顯著的技術突破



Market share of wafering tech.

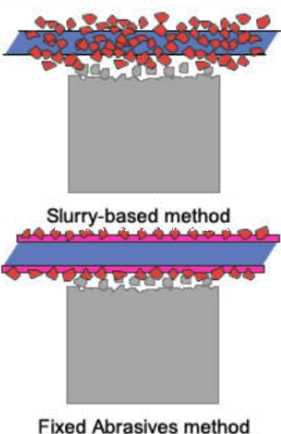
mono-Si

multi-Si



✓ 實際上DW切單晶片已達90%以上 (by GCL)

➤ Comparison of slurry and DW-based

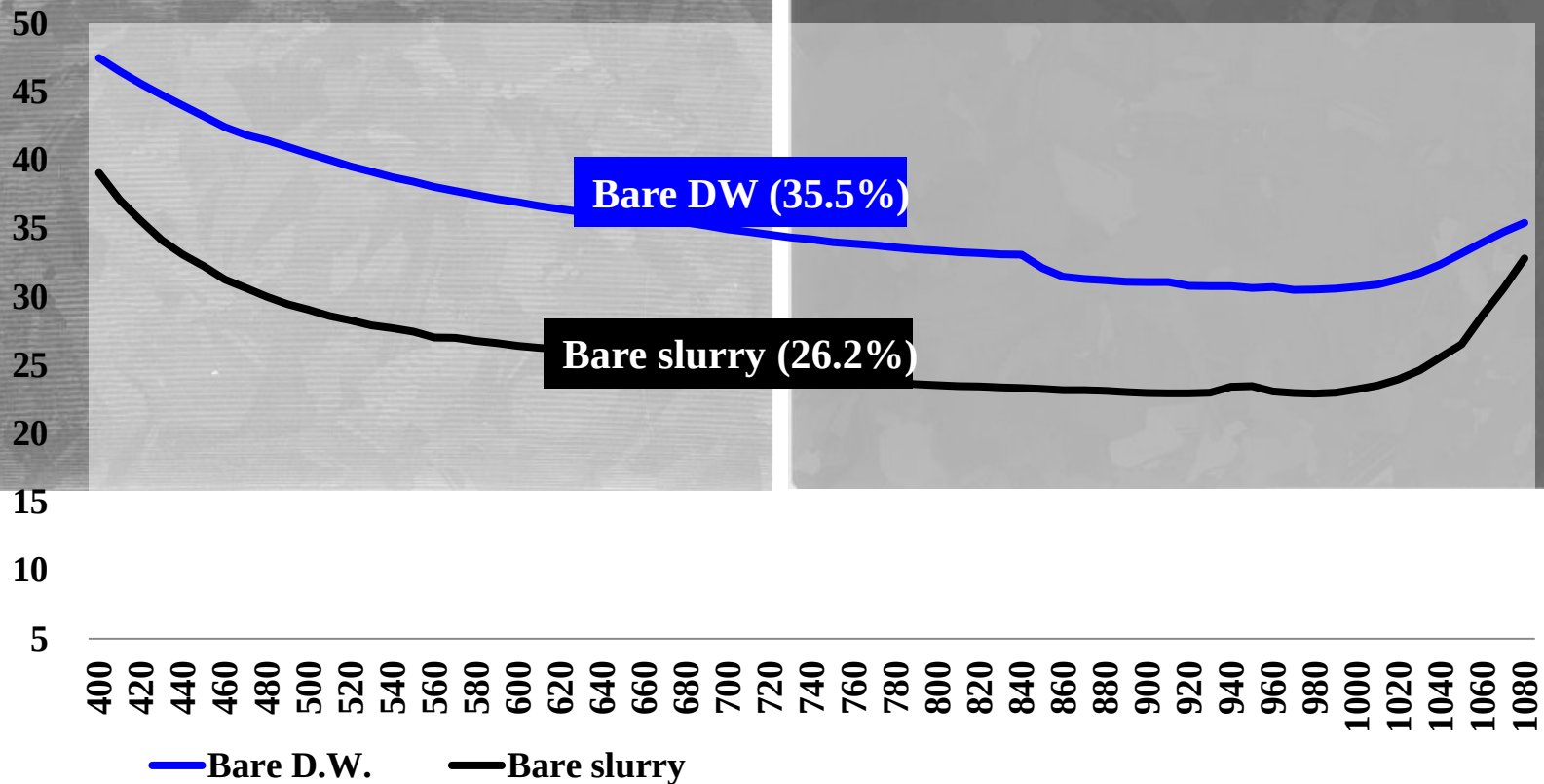


	切削油	粉	線	廢棄物處理	Cycle time	回片率
Slurry-based	PEG, DEG..	Si C	鋼琴線	油/粉/廢水	慢	低
DW-based	水系	NA	鑽石線	環境友好	快	高

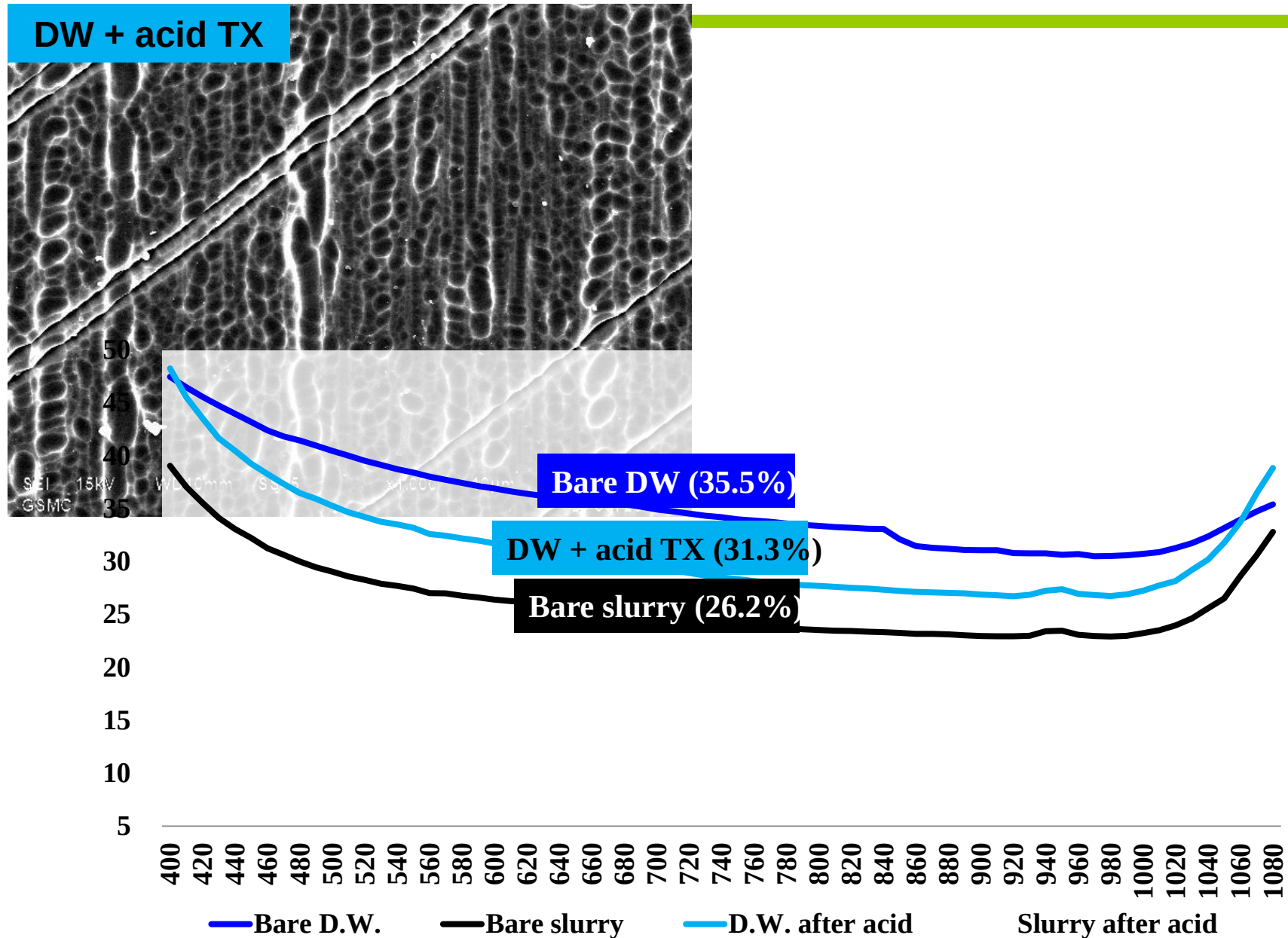
Comparison of DW & SW

**Bare DW
wafer**

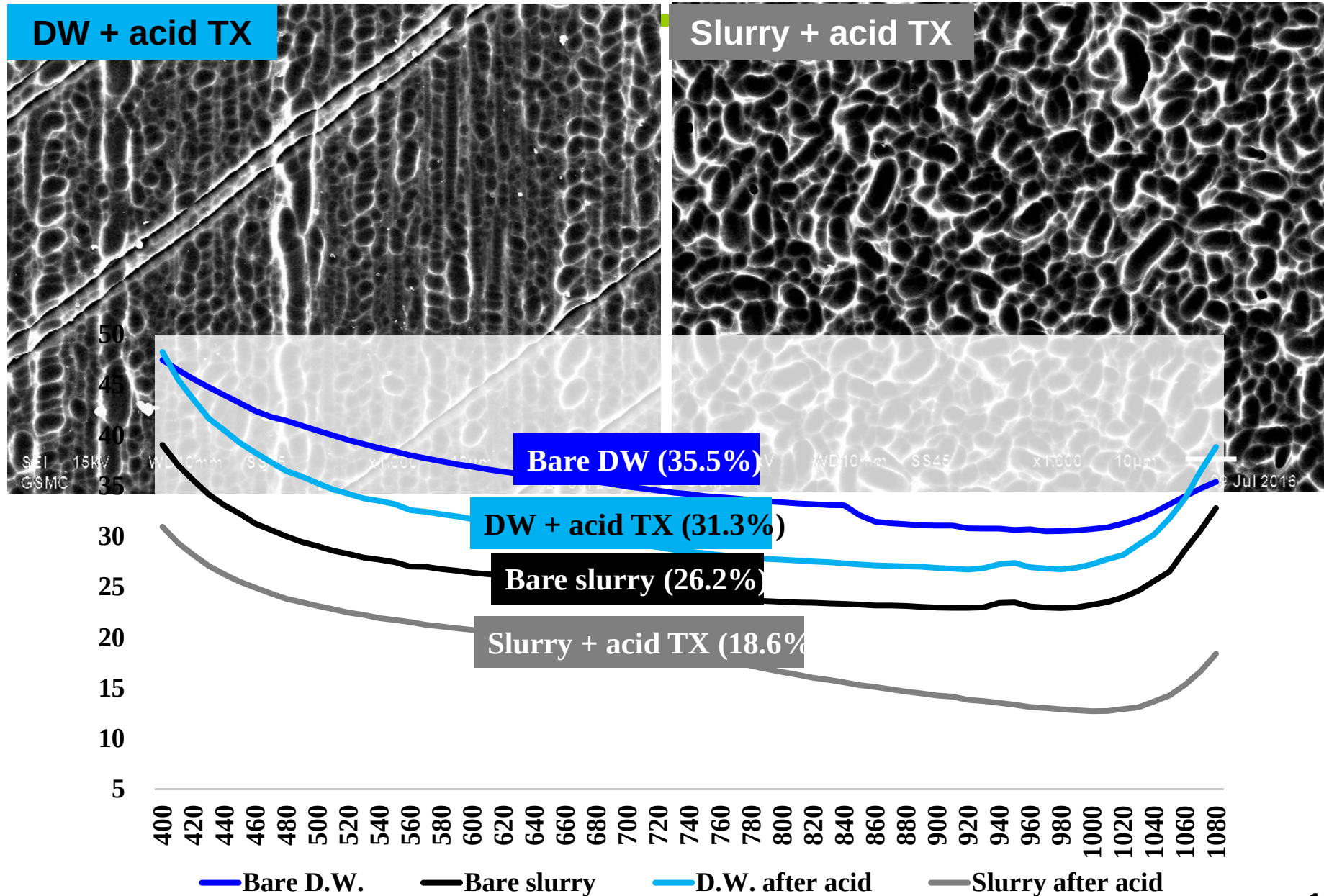
**Bare slurry
wafer**



Comparison of DW & SW

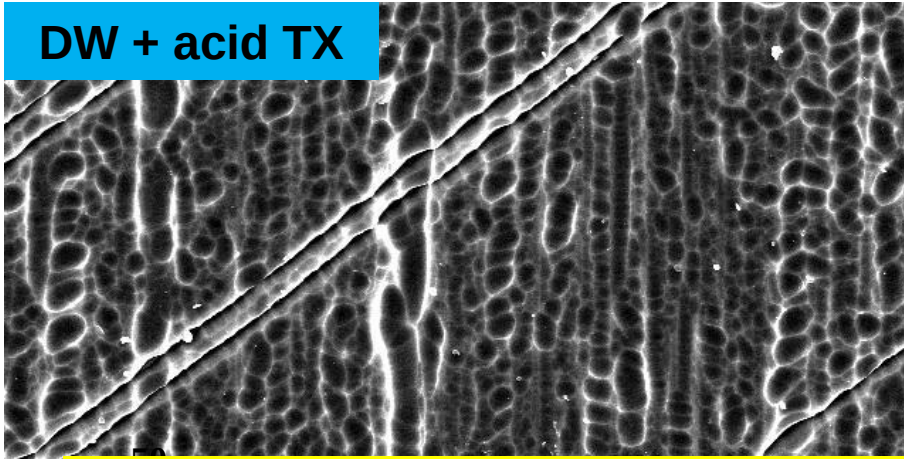


Comparison of DW & SW

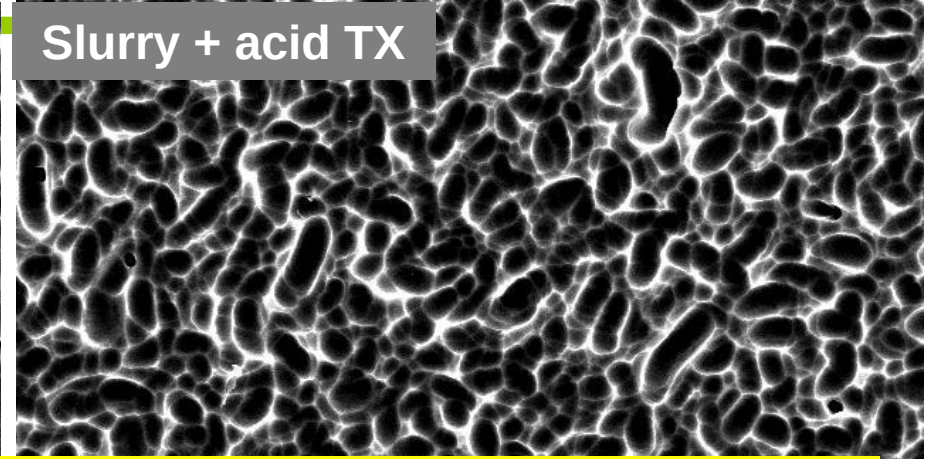


Comparison of DW & SW

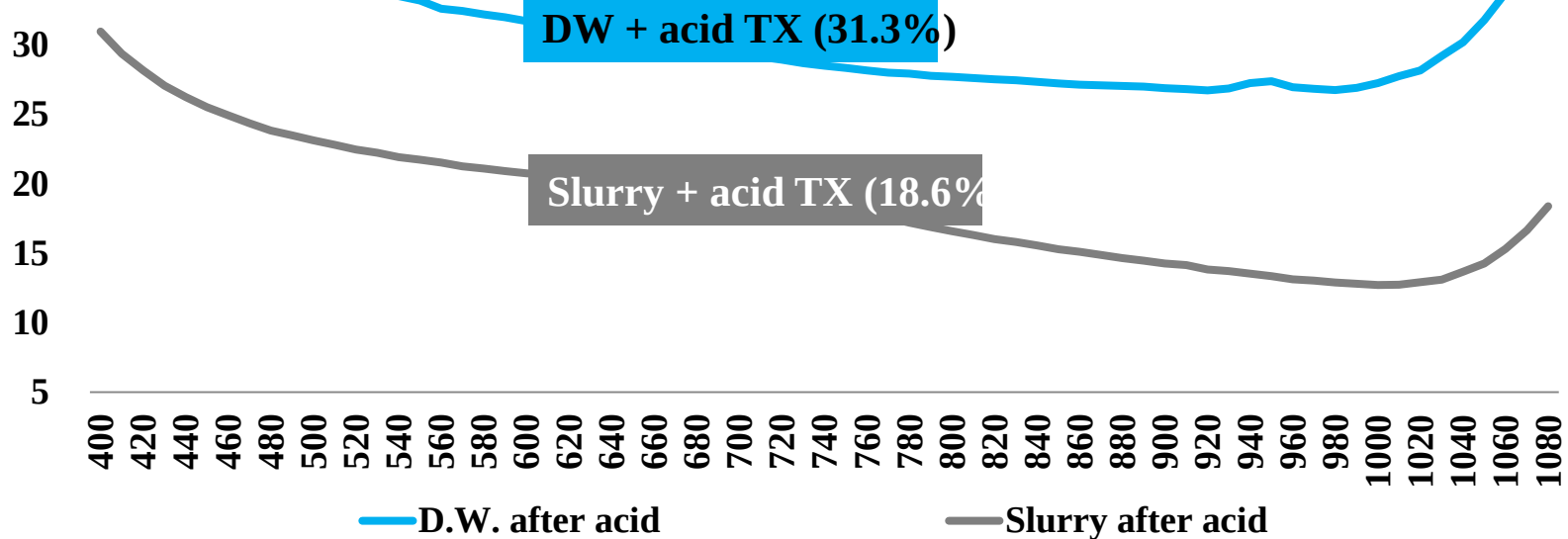
DW + acid TX



Slurry + acid TX



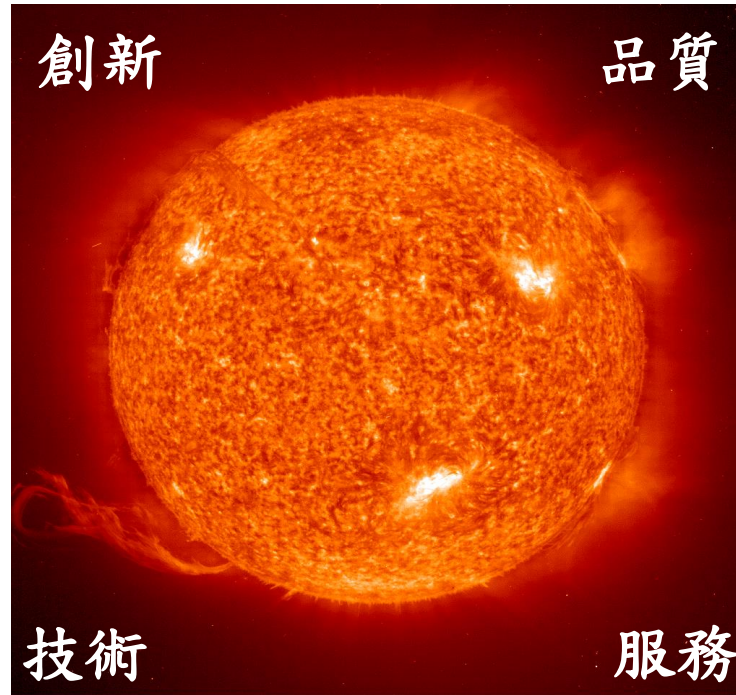
✓ 表面陷光差異(R%)需要由特殊制絨技術搭配



2017年國碩展望

- 1)2016年底矽料長約結束,矽原料成本將貼近現貨價格
- 2)現有砂漿切片設備將逐漸改成鑽石切片,切片成本大幅下降
- 3)領先進入” 黑矽片制絨” 技術,效率大幅提升.
- 4)Ribbon預期會受惠於國內市場而成長可期.
- 5)低溫固材繼續擴大產品市場滲透率及佔有率.

Thanks for your attention !



國碩科技

www.gigastorage.com.tw

